

การออกแบบและสร้างอิเล็กทรอนิกส์เดือรชนิดตัว เลข

3.1 จุดประสงค์ในการสร้าง

1. เพื่อให้สามารถวัดปริมาณประจุไฟฟ้าได้ในระดับ 10^{-9} ถึง 10^{-11} คูลอมบ์
2. เพื่อให้สามารถวัด ปริมาณไฟฟ้าอื่น ๆ ได้คือ วัดกระแสไฟฟ้าในระดับ 10^{-6} ถึง 10^{-10} แอมแปร์ และวัดศักย์ไฟฟ้าในระดับ 10^{-3} โวลต์
3. แสดงผลเป็นตัวเลข
4. ใช้อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายในประเทศ
5. มีคุณภาพและความสามารถในการทำงานสูง
6. ต้นทุนการผลิตต่ำ

จากจุดประสงค์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การเลือกใช้อุปกรณ์นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะทำให้สามารถสร้างอิเล็กทรอนิกส์เดือรได้ตามจุดประสงค์ทั้ง 6 ประการ ดังนั้นนอกจากจะใช้อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายในประเทศแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเที่ยงตรงในการวัดและราคาของอุปกรณ์ที่เลือกใช้อีกด้วย กล่าวคือ ถ้าต้องการความเที่ยงตรงสูงมาก ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีราคาสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง และในบางกรณีอาจหาซื้อไม่ได้ในประเทศ ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์จึงมีขอบเขตอยู่ที่การเลือกความเที่ยงตรงของการวัดให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ ราคาถูก และหาซื้อได้ในประเทศเพื่อความสะดวกในการสร้างและซ่อมแซม

3.2 ทฤษฎีเบื้องต้น

ในการประจุไฟฟ้าเข้าไว้ในตัวเก็บประจุ สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ได้ดังนี้

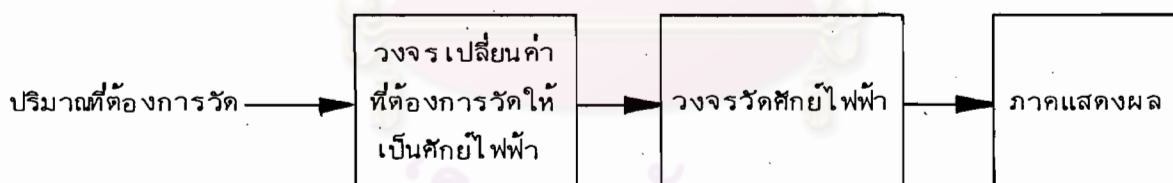
$$Q = CV \tag{3.1}$$

- เมื่อ Q = ปริมาณประจุไฟฟ้า (มีหน่วยเป็น คูลอมบ์)
 C = ค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ (มีหน่วยเป็น ฟารัด)
 V = ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของตัวเก็บประจุ
 (มีหน่วยเป็น โวลต์)

จากสมการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ถ้ากำหนดให้ ตัวเก็บประจุมีค่าความจุไฟฟ้า C คงที่ ปริมาณประจุไฟฟ้า Q ที่อยู่ภายในตัวเก็บประจุจะแปรผันกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า V ระหว่างปลายทั้งสองของตัวเก็บประจุ เราสามารถนำหลักการดังกล่าวมาใช้ในการสร้างอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการนำประจุไฟฟ้าที่ต้องการวัดมาประจุลงในตัวเก็บประจุที่ทราบค่า แล้วทำการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างปลายทั้งสองของตัวเก็บประจุนั้น ก็จะสามารถทราบปริมาณประจุไฟฟ้าที่ต้องการวัดได้

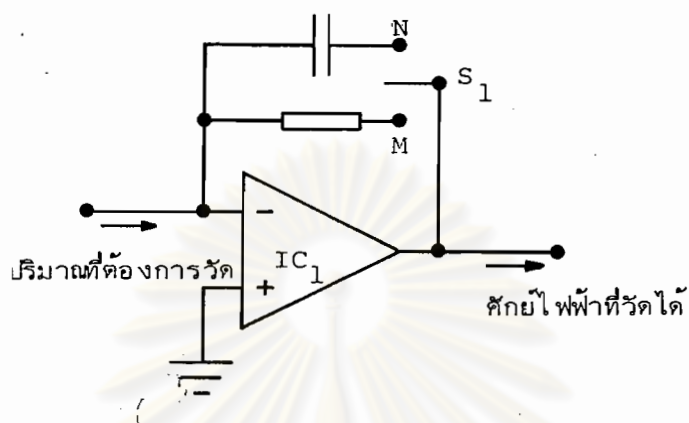
3.3 การออกแบบวงจร

แผนผังของวงจรที่ใช้เป็นดังนี้



3.3.1 วงจรเปลี่ยนค่าที่ต้องการวัดให้เป็นศักย์ไฟฟ้า

วงจรนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการวัดมีหลายชนิดด้วยกัน ดังนั้นวงจรนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนปริมาณต่าง ๆ ที่ต้องการวัด ซึ่งรับเข้ามาทางอินพุตให้เป็นศักย์ไฟฟ้า เพื่อนำให้กับวงจรวัดศักย์ไฟฟ้าต่อไป ลักษณะของวงจรที่ใช้แสดงไว้ในรูป 3.1



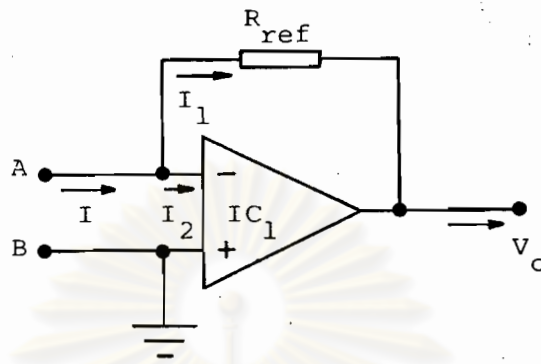
รูป 3.1 วงจรเปลี่ยนค่าที่ต้องการวัดให้เป็นศักย์ไฟฟ้า

จากรูป 3.1 IC_1 เป็นออปเปอเรชันแนล แอมพลิไฟเออร์ (Operational amplifier) ซึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า ออป-แอมป์ (Op-amp.) IC_1 จะทำหน้าที่เปลี่ยนปริมาณที่ต้องการวัดให้เป็นศักย์ไฟฟ้า โดยอาศัยคุณสมบัติประการหนึ่งของ ออป-แอมป์ คือ มีค่าความต้านทานของอินพุตสูง (High Input Impedance) รายละเอียดในการเปลี่ยนปริมาณต่าง ๆ ให้เป็นศักย์ไฟฟ้ามีดังนี้

3.3.1.1 วงจรเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นศักย์ไฟฟ้า

ในการวัดกระแสไฟฟ้า จะต้องสับสวิตช์ S_1 (ในรูป 3.1)

ไปยังตำแหน่ง M ดังนั้นวงจรที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าจะเป็นดังรูป 3.2



รูป 3.2 วงจรที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า

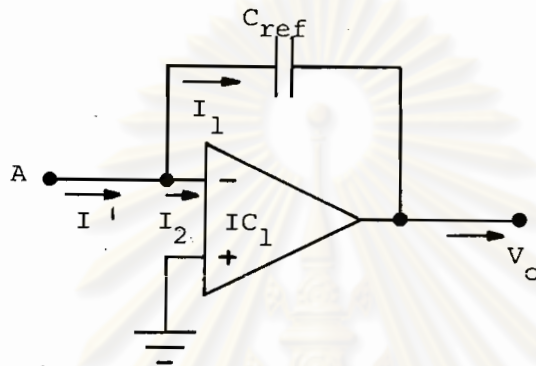
เมื่อต่อวงจรภายนอกที่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้า เข้าที่ตำแหน่ง A และ B กระแสไฟฟ้า I จะไหลเข้าสู่วงจรที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าแล้วจึงแยกไหลเป็น I_1 และ I_2 เนื่องจากออป-แอมป์ มีค่าความต้านทานทางอินพุตสูง ดังนั้นจึงอาจสมมติได้ว่า I_2 มีค่าเป็นศูนย์ กระแส I ทั้งหมดที่ต้องการวัดจึงไหลผ่าน R_{ref} นั่นคือ $I_1 = I$ และจากคุณสมบัติอีกประการหนึ่งของออป-แอมป์ คือ ศักย์ไฟฟ้าที่ขาอินพุตลบและขาอินพุตบวกจะมีค่าเท่ากัน เสมอถ้าไม่มีศักย์ออฟเซ็ททางอินพุต (Zero Input Offset Voltage) ดังนั้นเมื่อขาอินพุตบวกต่อกับกราวด์จึงถือได้ว่า ศักย์ไฟฟ้าที่ขาอินพุตลบเป็นกราวด์เสมือน (Virtual Ground) ทำให้ศักย์ไฟฟ้าทางเอาต์พุต (V_o) มีค่า ดังนี้

$$V_o = I R_{ref} \quad (3.2)$$

จะเห็นได้ว่า ศักย์ไฟฟ้าทางเอาต์พุตขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้า I ที่ต้องการวัดและความต้านทาน R_{ref} ดังนั้น เมื่อเลือกใช้ R_{ref} คงที่ค่าหนึ่ง ศักย์ไฟฟ้าทางเอาต์พุตก็จะแปรตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องการวัด และเนื่องจากศักย์ไฟฟ้าที่จุด A และ B มีค่าเท่ากัน (จากคุณสมบัติของออป-แอมป์) จึงถือได้ว่า วงจรที่ใช้วัดกระแสนี้จะไม่รบกวนหรือทำให้การทำงานของวงจรที่ต้องการวัด กระแสมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงสามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ถูกต้อง

3.3.1.2 วงจรเปลี่ยนประจุไฟฟ้าให้เป็นศักย์ไฟฟ้า

ในการวัดประจุไฟฟ้าจะต้องสลับสวิทช์ S_1 (ในรูป 3.1) ไปที่ตำแหน่ง N ดังนั้น วงจรที่ใช้ในการวัดประจุไฟฟ้าจะเป็นดังรูป 3.3



รูป 3.3 วงจรที่ใช้ในการวัดประจุไฟฟ้า

ในการวัดประจุไฟฟ้านั้นจะต้องนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปแตะที่จุด A ซึ่งเป็นขาอินพุทของวงจร จะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า นั่นคือจะมีกระแสไฟฟ้า I ไหลเข้าสู่วงจรวัดประจุไฟฟ้า และในทำนองเดียวกับกรณีวัดกระแสไฟฟ้าคือ ที่จุด A กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าทั้งหมด จะไหลเข้าสู่ C_{ref} นั่นคือ ประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่ถ่ายเทมายังจุด A จะถูกเก็บไว้ใน C_{ref} และ V_o จะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของ C_{ref} จากสมการ (3.1) จะได้

$$V_o = \frac{Q}{C_{ref}} \quad (3.3)$$

จะเห็นได้ว่าศักย์ไฟฟ้าทางเอาต์พุท (V_o) จะขึ้นอยู่กับปริมาณประจุไฟฟ้าที่ต้องการวัด (Q) และค่าความจุไฟฟ้า (C_{ref}) ของตัวเก็บประจุที่ใช้ในวงจร ดังนั้นถ้าเลือกใช้ C_{ref} คงที่ค่าหนึ่งศักย์ไฟฟ้าทางเอาต์พุทก็จะแปรตามปริมาณประจุไฟฟ้าที่ต้องการวัด

3.3.2 วงจรที่ใช้ในการวัดศักย์ไฟฟ้า

วงจรที่ใช้วัดศักย์ไฟฟ้านั้นนอกจากจะทำหน้าที่วัดศักย์ไฟฟ้าจากวงจรภายนอกโดยตรงแล้ว ยังทำหน้าที่วัดศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากวงจรวัดกระแสและประจุไฟฟ้าอีกด้วย เนื่องจากในการสร้างอิเล็กทรอนิกส์ไมโครมิเตอร์นี้ต้องการให้การวัดมีความเที่ยงตรงสูง สะดวกในการสร้างและซ่อมแซม จึงใช้วงจรวัดศักย์ไฟฟ้าแบบชิ้นเดียว (Single Chip DVM) ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป

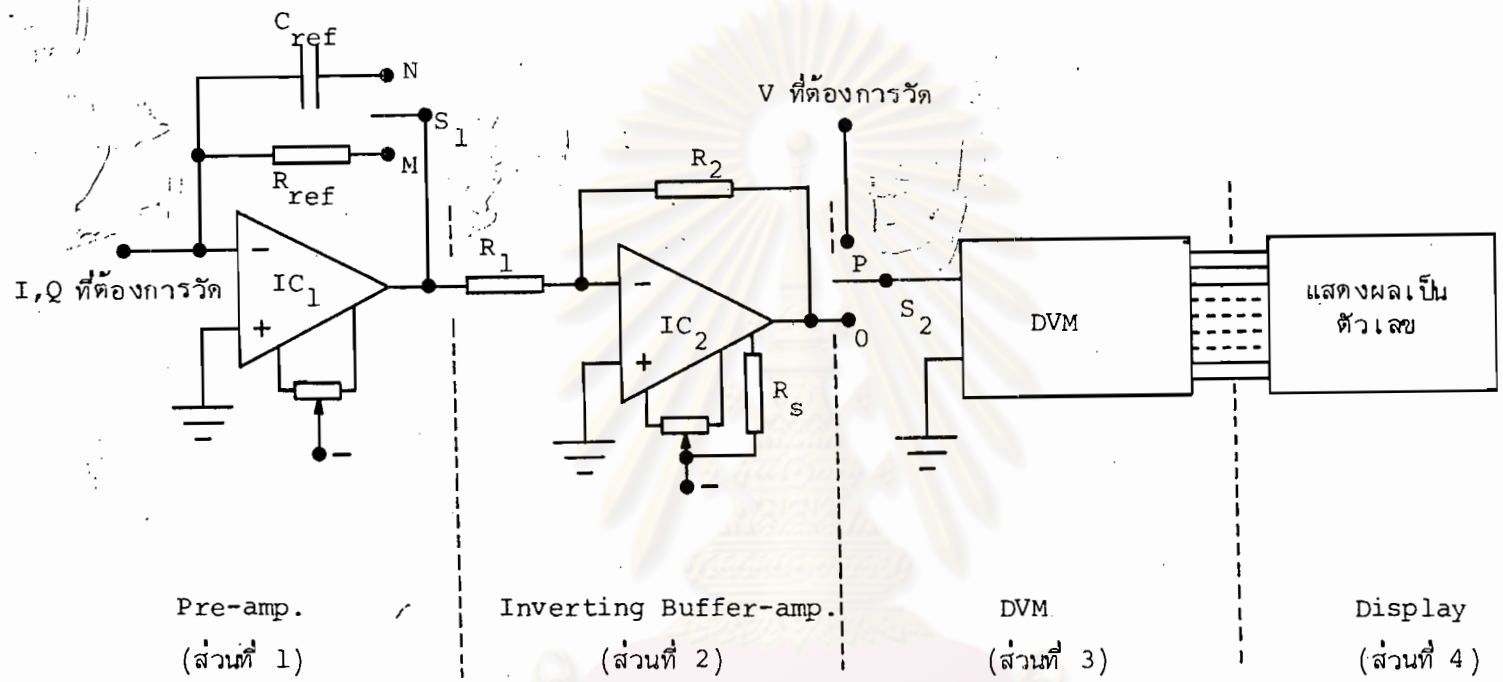
3.3.3 ภาคแสดงผล

ภาคแสดงผลจะทำหน้าที่แสดงค่าที่ได้รับจากวงจรวัดศักย์ไฟฟ้า โดยการแสดงผลเป็นตัวเลข ซึ่งอิเล็กทรอนิกส์ไมโครมิเตอร์ที่สร้างขึ้นนี้ใช้ระบบการแสดงผลเป็นแบบ LCD (LCD : Liquid Crystal Display) ขนาด $3 \frac{1}{2}$ หลัก

3.4 หลักการทำงานของวงจรและการเลือกใช้อุปกรณ์

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น จะเห็นว่า ในการเลือกใช้อุปกรณ์นั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ในการสร้างอิเล็กทรอนิกส์ไมโครมิเตอร์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงหลักการทำงานของวงจรที่ใช้อีกด้วยสำหรับวงจรที่ใช้ในการสร้างอิเล็กทรอนิกส์ไมโครมิเตอร์นี้อาจแบ่งได้เป็น ๔ ส่วนดังรูป 3.4

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูป 3.4 วงจรแสดงหลักการการทำงานของอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล

ส่วนที่ 1 เป็นพรี-แอมป์ (Pre-amp : Pre-amplifier) ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าที่ต้องการวัดให้เป็นศักย์ไฟฟ้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ซึ่งอาจเรียกส่วนนี้ว่า คอนเวอร์เตอร์ (Converter) ดังนั้น IC₁ ที่ใช้ในวงจรส่วนนี้จะต้องมีลักษณะพิเศษดังนี้

1. มีค่าความต้านทานทางอินพุตสูง (สูงกว่า $10^{10} \Omega$)
2. มีค่ากระแสไฟเลี้ยงทางอินพุต (Input Bias Current) ต่ำ (ต่ำกว่า 200 pA.)
3. มีค่ากระแสออฟเซต (Offset Current) และศักย์ออฟเซต (Offset Voltage) ต่ำ
4. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีผลต่อการทำงานของวงจรภายในน้อยมาก
5. มีความเสถียร (Stability) สูง
6. ใช้กระแสเลี้ยงวงจรภายใน (Supply Current) ต่ำ

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ IC ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบัน พบว่า IC ที่มีคุณสมบัติที่สุดและครบถ้วนทั้ง 6 ประการคือ IC เบอร์ LH0022CH จึงเลือกใช้ IC เบอร์ดังกล่าว (ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ก.)

นอกจากนี้ R_{ref} และ C_{ref} ที่ใช้จะต้องมีความเที่ยงตรงสูง และ C_{ref} จะต้องมีการเสารั่วไหลต่ำอีกด้วย จึงเลือกใช้ชนิดที่มีความผิดพลาดไม่เกิน 1 %

ส่วนที่ 2 เป็นอินเวอร์ตติ้ง บัฟเฟอร์-แอมป์ (Inverting Buffer-amp.) ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนโพลาริตี (Polarity) ของศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากพรีแอมป์ซึ่งมีการทำงานเป็นแบบอินเวอร์ตติ้ง ให้ตรงกับโพลาริตีของปริมาณที่ต้องการวัดก่อนที่จะส่งไปยังวงจรวัดศักย์ไฟฟ้า ดังนั้นวงจรส่วนที่ 2 นี้จะต้องมีกำลังขยายเป็น 1 นั่นคือ R₁ และ R₂ จะต้องมามีค่าเท่ากัน สำหรับ IC₂ ที่ใช้ในวงจรนี้จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้

1. มีค่าศักย์ออฟเซตต่ำ
2. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีผลต่อการทำงานของวงจรภายในน้อยมาก
3. มีความเสถียรสูง
4. ใช้กระแสเลี้ยงวงจรภายในต่ำ

จากคุณสมบัติทั้ง 4 ประการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า IC₂ ที่ใช้ในวงจรนี้ควรเป็นออป-แอมป์ชนิดโปรแกรมเมเบิล (Programable Op-amp.) ซึ่งสามารถกำหนดคุณสมบัติของออปแอมป์นั้นได้ โดยเลือกค่า R_S ที่ใช้ ดังนั้นในวงจรส่วนนี้จึงเลือกใช้ IC เบอร์ LM 4250 (ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ข) และเลือกใช้ R_S = 10 MΩ

ส่วนที่ 3 เป็นโวลต์มิเตอร์ชนิดตัวเลข (Digital Voltmeter: DVM) ทำหน้าที่ในการวัดศักย์ไฟฟ้า มีสวิตช์ S₂ เพื่อใช้เลือกศักย์ไฟฟ้าที่ต้องการวัด กล่าวคือ เมื่อต้องการวัดศักย์ไฟฟ้าจากวงจรภายนอกก็ต้องสับสวิตช์ S₂ ไปที่ตำแหน่ง P แต่ถ้าต้องการวัดศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากวงจรส่วนที่ 2 (ซึ่งเกิดจากประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ต้องการวัด) ก็ต้องสับสวิตช์ S₂ ไปที่ตำแหน่ง 0 วงจรส่วนที่ 3 ที่ใช้นี้เป็นแบบวงจรรวมขึ้นเดี่ยว (Single Chip DVM) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีผลต่อการทำงานของวงจรภายในน้อยมาก
2. มีความเสถียรสูง
3. ใช้กระแสเลี้ยงวงจรต่ำ
4. มีช่วงการวัดศักย์ไฟฟ้าเหมาะสมกับศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากวงจรส่วนที่ 2

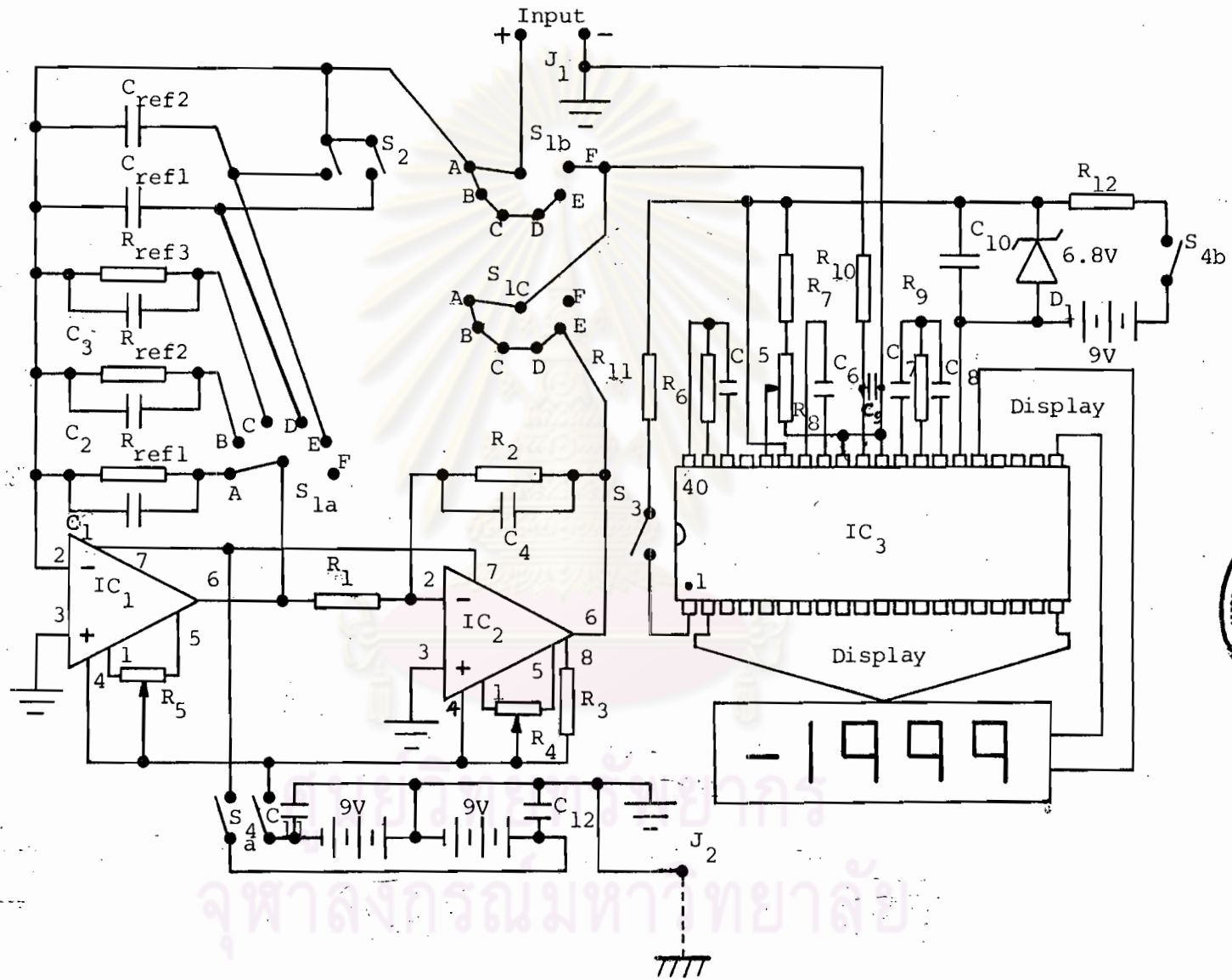
วงจรรวมเดี่ยวที่เลือกใช้ในวงจรส่วนนี้คือ IC เบอร์ ICL7116 CPL (ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ค.)

ส่วนที่ 4 เป็นภาคแสดงผล (Display) ทำหน้าที่ในการแสดงผลที่ได้จากการวัดศักย์ไฟฟ้าจากส่วนที่ 3 ให้แสดงผลออกมาเป็นตัวเลข โดยใช้ระบบการแสดงผลแบบ LCD ขนาด 3 $\frac{1}{2}$ หลัก ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงโพลาริตีของปริมาณที่วัดไว้ด้วย เหตุที่เลือกใช้ระบบการแสดงผลแบบ LDC เนื่องจากระบบการแสดงผลแบบ LCD นี้จะกินกระแสต่ำกว่าแบบอื่น

3.5 วงจรที่ใช้และการทำงานของวงจร

3.5.1 วงจรที่ใช้

วงจรที่ใช้ในการสร้างอิเล็กทรอนิกส์โวลต์มิเตอร์ชนิดตัวเลขนี้ แสดงไว้ในรูป 3.5



รูป 3.5 วงจรที่ใช้ในการสร้างอิเล็กทรอนิกส์

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในวงจรในรูป 3.5 มีดังนี้ :

R_1, R_2	10 K Ω (1 %)
R_3	10 M Ω (5 %)
R_4	200 K Ω (15 รอบ)
R_5	5 K Ω (15 รอบ)
R_6	100 K Ω (5 %)
R_7	24 K Ω (5 %)
R_8	25 K Ω (15 รอบ)
R_9	470 K Ω (5 %)
R_{10}	1 M Ω (5 %)
R_{11}	1 K Ω (5 %)
R_{12}	680 Ω (5 %)
C_1, C_2, C_3, C_4, C_9	0.01 μ F (5 %)
C_5	100 pF (5 %)
$C_6, C_{10}, C_{11}, C_{12}$	0.1 μ F (5 %)
C_7	0.47 μ F (5 %)
C_8	0.22 μ F (5 %)
R_{ref1}	10M Ω (1 %)
R_{ref2}	100 K Ω (1 %)
R_{ref3}	1 K Ω (1 %)
C_{ref1}	.01 μ F (1 %)
C_{ref2}	1 μ F (1 %)

IC ₁	LH0022CH
IC ₂	LM4250CN
IC ₃	ICL7116CPL
D ₁	ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) 6.8 V (0.5 W)
S ₁	สวิตช์เลือก
S ₂	สวิตช์รีเซ็ต
S ₃	สวิตช์โฮล
S ₄	สวิตช์ปิด-เปิด
J ₁	ขั้วต่ออินพุท
J ₂	ขั้วต่อสายดิน

3.5.2 การทำงานของวงจร

จากรูป 3.5 IC₁ เป็นพี-แอมป์ ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าที่ต้องการวัดให้เป็นศักย์ไฟฟ้า โดยช่วงสเกลที่ใช้วัดนั้นขึ้นอยู่กับค่า R_{ref} และ C_{ref} ดังนี้

R _{ref1}	(ที่ตำแหน่ง A)	ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าในช่วง $\pm 1999 \times 10^{-10}$	แอมแปร์
R _{ref2}	(ที่ตำแหน่ง B)	ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าในช่วง $\pm 1999 \times 10^{-8}$	แอมแปร์
R _{ref3}	(ที่ตำแหน่ง C)	ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าในช่วง $\pm 1999 \times 10^{-6}$	แอมแปร์
C _{ref1}	(ที่ตำแหน่ง D)	ใช้ในการวัดประจุไฟฟ้าในช่วง $\pm 1999 \times 10^{-11}$	คูลอมบ์
C _{ref2}	(ที่ตำแหน่ง E)	ใช้ในการวัดประจุไฟฟ้าในช่วง $\pm 1999 \times 10^{-9}$	คูลอมบ์
S _{1a}	เป็นสวิตช์ที่ใช้เลือกค่า R _{ref} และ C _{ref} ที่ต้องการใช้		

R₄ และ R₅ ใช้ในการปรับค่าออฟเซตของ IC₂ และ IC₁ ตามลำดับ

C₁, C₂, C₃ และ C₄ ทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้สัญญาณที่มีความถี่สูง เข้ามารบกวนการทำงานของ IC₁ และ IC₂

IC₃ เป็น DVM แบบวงจรขึ้นเดียว ซึ่งกำหนดให้ V_{ref} ของวงจรภายในมีเท่ากับ 1 โวลต์ โดยการปรับค่า R₈ (V_{ref} วัดที่ขา 32 และ 36 ของ IC₃)

D_1 ทำหน้าที่จ่ายศักย์ไฟฟ้าให้กับ IC_3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.8 โวลต์

C_{10} , C_{11} และ C_{12} ทำหน้าที่ป้องกันสัญญาณความถี่สูงที่จะเข้ามารบกวนการทำงานของวงจรทั้งหมด

S_{1b} เป็นสวิตช์ที่เลือกให้ปริมาณที่ต้องการวัด เข้าที่อินพุทของ IC_1 หรือ IC_3

S_{1c} เป็นสวิตช์ที่เลือกให้เอาพุทจาก IC_2 เข้าที่อินพุทของ IC_3 หรือปล่อยลอยไว้

(Float)

S_{1a} , S_{1b} และ S_{1c} เป็นสวิตช์ที่อยู่ในตัวเดียวกันและการทำงานจะสัมพันธ์กัน เสมอ กล่าวคือในกรณีที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าจะต้องสับสวิตช์ไปที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในระหว่าง A - E แต่ในกรณีที่ใช้วัดศักย์ไฟฟ้าจะต้องสับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง F

S_3 เป็นสวิตช์โฮล ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ต้องการให้ค่าที่วัดได้ค้างอยู่บนภาคแสดงผล

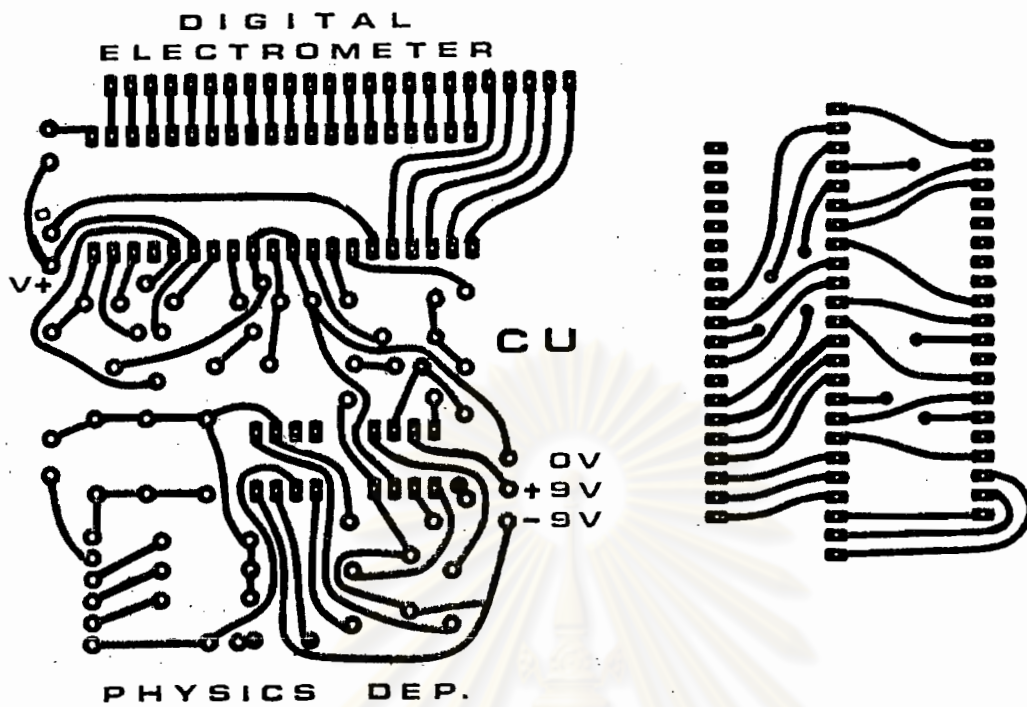
S_2 เป็นสวิตช์รีเซ็ต ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ต้องการคายประจุไฟฟ้าออกจาก C_{ref1} และ C_{ref2} เนื่องจากในการวัดประจุไฟฟ้าจะต้องสับสวิตช์รีเซ็ต ก่อนทุกครั้ง เพื่อคายประจุไฟฟ้าที่อาจเหลืออยู่ใน C_{ref1} หรือ C_{ref2} ซึ่งจะเป็นผลให้วัดค่าประจุไฟฟ้าได้ถูกต้อง

3.6 การออกแบบลายวงจรพิมพ์

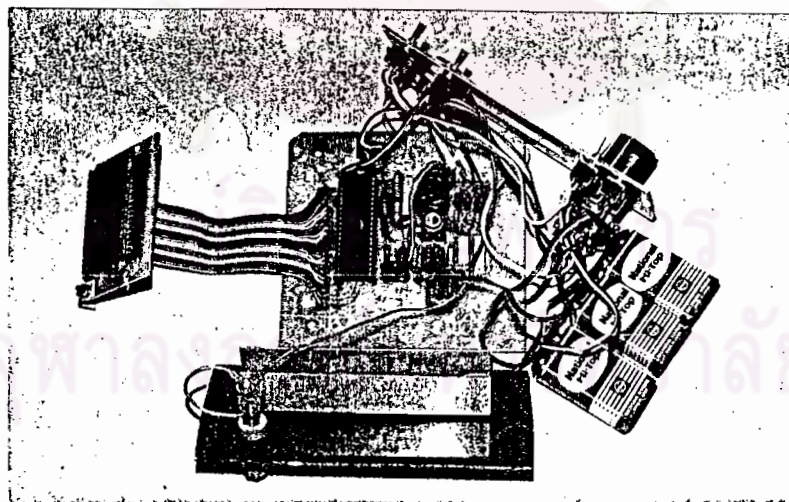
การออกแบบลายวงจรพิมพ์ (Printed Circuit) เป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งในการสร้างอิเล็กทรอนิกส์ชนิดตัวเลขนี้ เพราะเหตุว่าถ้าการออกแบบลายวงจรพิมพ์ไม่ดีพอ จะทำให้เกิดสัญญาณไปรบกวนการทำงานของวงจรที่สร้างขึ้นได้

หลักการออกแบบวงจรพิมพ์อาจแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

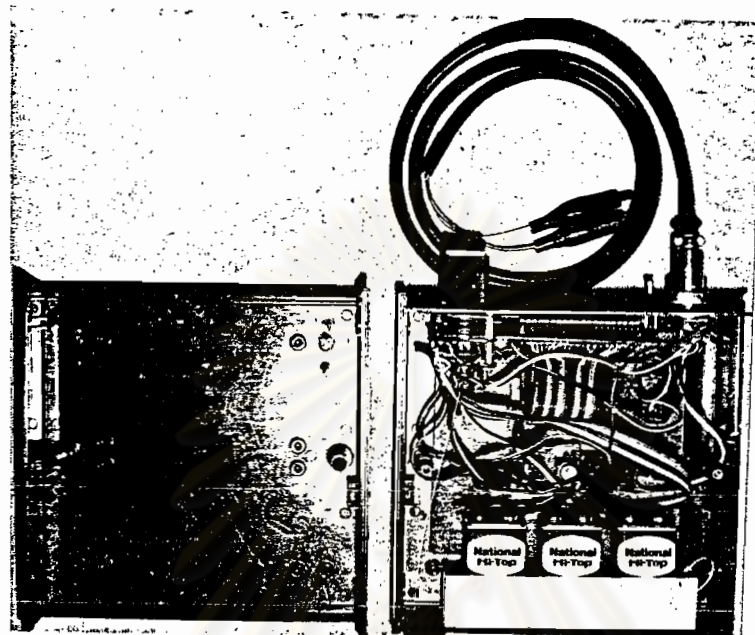
1. ลายวงจรจะต้องมีขนาดเส้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2. ต้องแยกส่วนลายวงจรของ DVM ออกจากวงจรพรี-แอมป์ เพื่อป้องกันสัญญาณที่ใช้ในการทำงานภายใน DVM มารบกวนวงจรพรี-แอมป์
3. ศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้วงจรของ DVM และวงจรพรี-แอมป์ จะต้องแยกจากกันเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
4. การออกแบบลายเส้นกราวด์ (Ground) จะต้องไม่ทำให้เกิดกราวด์ลูป (Ground Loop) เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนอันอาจจะเกิดจากส่วนต่าง ๆ ของวงจร
5. แผ่นปริ้นท์ที่ใช้ควรเป็นแบบอีพ็อกซี (Epoxy) เพื่อป้องกันการเกิดกระแสรั่วไหลและเกิดค่าความจุไฟฟ้าระหว่างลายวงจรที่อยู่ใกล้กัน



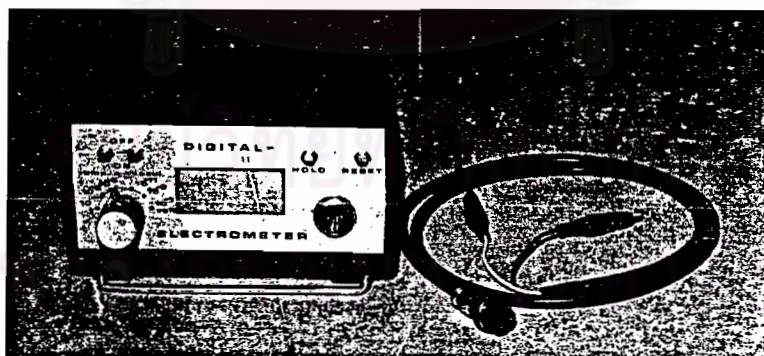
รูป 3.6 ลายวงจรมิมพ์



รูป 3.7 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบบนลายวงจรมิมพ์



รูป 3.8 การจัดส่วนประกอบต่างๆ ลงในกล่อง



รูป 3.9 อิเล็กโตรมิเตอร์ชนิดตัวเลขที่สร้างและประกอบเสร็จแล้ว